

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年6月12日(12.06.2025)



(10) 国際公開番号

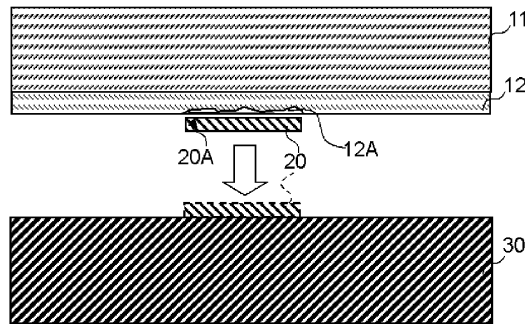
WO 2025/120743 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/02 (2006.01) *G09F 9/33* (2006.01)
G09F 9/00 (2006.01) *H01L 33/62* (2010.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/043506
- (22) 国際出願日: 2023年12月5日(05.12.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人: 信越化学工業株式会社 (SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1000005 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 (JP). 信越エンジニアリング株式会社 (SHIN-ETSU ENGINEERING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1010054 東京都千代田区神田錦町2丁目9番地 (JP).
- (72) 発明者: 小川 敬典 (OGAWA Yoshinori); 〒1000005 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 信越化学工業株式会社 本社内 (JP). 北川 太一 (KITAGAWA Taichi); 〒3790224 群馬県

安中市松井田町人見1番地10 信越化学工業株式会社 シリコン電子材料技術研究所内 (JP). 池田 達彦 (IKEDA Tatsuhiko); 〒3790224 群馬県安中市松井田町人見1番地10 信越化学工業株式会社 シリコン電子材料技術研究所内 (JP). 須永 誠寿郎 (SUNAGA Seiji); 〒1000005 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 信越化学工業株式会社 本社内 (JP). 鈴木 智也 (SUZUKI Tomoya); 〒3790127 群馬県安中市磯部二丁目2-45 信越エンジニアリング株式会社内 (JP). 植森 信隆 (UEMORI Nobutaka); 〒2340053 神奈川県横浜市港南区日野中央2丁目22-52 S A L 株式会社内 (JP). 宇佐美 健人 (USAMI Taketo); 〒2340053 神奈川県横浜市港南区日野中央2丁目22-52 S A L 株式会社内 (JP). 山岡 裕 (YAMAOKA Hiroshi); 〒2340053 神奈川県横浜市港南区日野中央2丁目22-52 S A L 株式会社内 (JP).

(54) Title: TRANSFER METHOD, TRANSFER UNIT, METHOD FOR MANUFACTURING DISPLAY DEVICE, AND METHOD FOR MANUFACTURING MOUNTING BOARD

(54) 発明の名称: 転写方法、転写ユニット、表示装置の製造方法、及び実装基板の製造方法



(57) Abstract: The present invention provides a transfer method for transferring a structure to a transfer destination, the transfer method comprising: preparing a release plate including a base material, a resin layer provided on the base material and having a transfer laser transmittance of 90% or more, and a structure held on the surface of the resin layer on the opposite side from the base material; causing the transfer laser to be incident on the base material from the surface of the base material on the opposite side from the resin layer; and causing the incident transfer laser to be transmitted through the base material and the resin layer and thermally decompose at least a portion of the resin layer at the interface where the structure and the resin layer are in contact, thereby transferring the structure from the release plate to the transfer destination. This makes it possible to provide a transfer method whereby a structure can be transferred to a transfer destination at high precision.

[続葉有]

WO 2025/120743 A1

(74) 代理人: 好宮 幹夫, 外 (YOSHIMIYA Mikio et al.); 〒1100005 東京都台東区上野 7 丁目 6 番 1 1 号 第一下谷ビル 8 F (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 本発明は、構造体を転写先に転写する転写方法であって、基材と、前記基材上に設けられ、転写レーザの透過率が90%以上である樹脂層と、前記樹脂層の前記基材とは反対側の面に保持された構造体とを含むリリースプレートを準備することと、前記転写レーザを、前記基材の前記樹脂層とは反対側の面から前記基材に入射させることと、前記入射された転写レーザは、前記基材及び前記樹脂層を透過し、前記構造体と前記樹脂層とが接している界面で前記樹脂層の少なくとも一部を熱分解させ、前記構造体を前記リリースプレートから転写先に転写することを含む、転写方法である。これにより、高い精度で構造体を転写先に転写できる転写方法を提供できる。